

Тематический указатель статей, опубликованных в 2018 году

Фундаментальные исследования

Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Писаренко И.В. Исследование транспорта носителей заряда в инжекционном лазере с частотной модуляцией оптического излучения. Т. 23, № 3, с. 217–229.

Лавров И.В. Прогнозирование оптических свойств матричных композитов со сферическими включениями с металлической оболочкой. Т. 23, № 2, с. 113–123.

Усанов Д.А., Постельга А.Э., Гуров К.А. Измерение эффективных масс электропроводности и плотности состояний бесконтактными сверхвысокочастотными методами. Т. 23, № 1, с. 5–14.

Яременко Н.Г., Страхов В.А., Карачевцева М.В. Влияние эффективности захвата дырок на температурную зависимость фотолюминесценции структур $n\text{-AlGaAs/GaAs}$ с квантовыми ямами. Т. 23, № 4, с. 327–334.

Материалы электроники

Гришина Я.С., Боргардт Н.И., Волков Р.Л., Громов Д.Г., Савицкий А.И. Электронно-микроскопические исследования наночастиц серебра, полученных вакуумно-термическим испарением. Т. 23, № 6, с. 543–556.

Зарецкая Е.П., Гременок В.Ф., Станчик А.В., Петлицкий А.Н., Солодуха В.А., Уразов К.А., Дергачева М.Б., Сулейман Осцелик, Дюжнев Н.А., Алексеев А.М. Структурные и оптические свойства тонких пленок $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$. Т. 23, № 3, с. 230–239.

Неустроев С.А., Неустроев Н.С. Теоретическое определение диэлектрической проницаемости кубического углерода. Т. 23, № 5, с. 439–445.

Ревин М.В., Котков А.П., Иванов В.А., Радьков Ю.Ф., Свинков Н.В., Артемов А.Н., Грибов Б.Г. Исследование влияния электрически активных примесей, поступающих из синтезированного различными методами триметилгаллия, на электрофизические характеристики эпитаксиальных слоев арсенида галлия. Т. 23, № 3, с. 240–251.

Технологические процессы и маршруты

Белов А.Н., Голишников А.А., Мاستинин А.М., Перевалов А.А., Шевяков В.И. Исследование процесса формирования мемристорных структур на основе сульфида меди. Т. 23, № 6, с. 565–572.

Вигдорovich Е.Н. Исследование состава пара теллура статическим методом. Т. 23, № 5, с. 446–453.

Вигдорovich Е.Н. Прогнозирование условий газофазной эпитаксии соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$. Т. 23, № 4, с. 335–344.

Гаврилин В.А., Каракеян В.И., Рябышенков А.С. Оценка эффективности системы кондиционирования воздуха чистых производственных помещений с учетом термодинамических параметров. Т. 23, № 2, с. 133–140.

Егоркин В.И., Земляков В.Е., Неженцев А.В., Гармаш В.И. Исследование методов вжигания омических контактов к *n*-слоям гетеробиполярных наногетероструктур. Т. 23, № 1, с. 15–22.

Егоркин В.И., Земляков В.Е., Неженцев А.В., Гудков В. А., Гармаш В.И. Влияние состава металлизации и параметров процесса вжигания на сопротивление омических контактов к 6H-SiC *n*-типа. Т. 23, № 6, с. 557–564.

Петренко Н.Ю., Пучнина С.В., Гаврилов С.А. Математическая модель процесса испарения компонентов амальгамы в разрядных источниках излучения. Т. 23, № 2, с. 124–132.

Поголов А.И., Блинов Г.А., Чугунов Е.Ю. Моделирование клеевых соединений для обеспечения надежности трехмерных микроэлектронных модулей. Т. 23, № 1, с. 23–31.

Рехвиашвили С.Ш., Мамчуев М.О., Нарожнов В.В., Ойхунов М.М., Тлибеков А.Х. Исследование влияния плотности монтажа компонентов на колебательные характеристики многослойных печатных плат. Т. 23, № 2, с. 141–148.

Федотов С.Д., Соколов Е.М., Стаценко В.Н., Ромашкин А.В., Тимошенков С.П. Исследование технологических режимов газофазного формирования начального слоя кремния на сапфире. Т. 23, № 5, с. 454–467.

Ханг Тхи Нгуен, Якубов А.О., Лазаренко П.И., Волкова А.В., Шерченков А.А., Козюхин С.А. Особенности характеристик аморфных полупроводниковых пленок As₂S₃, полученных методом центрифугирования раствора. Т. 23, № 2, с. 149–160.

Элементы интегральной электроники

Булатов З.В., Путилин А.Н., Супонников Д.А., Кочетов А.В., Татарина Е.А., Дабагов А.Р. Анализ схем построения стеков преобразования рентгеновского излучения и моделирование процессов формирования сигнала рентгеновского изображения в фотоприемнике. Т. 23, № 2, с. 173–185.

Елизаров Г.С., Корнеев В.В., Тарасов И.Е., Советов П.Н. Основные тенденции развития архитектур специализированных многоядерных процессоров. ОБЗОР. Т. 23, № 2, с. 161–172.

Жаднов В.В. Модель отказов электронных компонентов для расчета надежности. Т. 23, № 4, с. 353–361.

Королёв М.А., Ключников А.С., Ефимова Д.И. Беспереходной МОП-транзистор с низким подпороговым током. Т. 23, № 2, с. 186–193.

Королев М.А., Ключников А.С., Ефимова Д.И. Влияние расположения контактов стокистоковых областей на параметры беспереходного КНИ МОП-транзистора. Т. 23, № 4, с. 345–352.

Рыбаков А.А., Резниченко Н.Е. Измерение нелинейности АЦП при входном сигнале неполной шкалы. Т. 23, № 1, с. 32–39.

Сопова О.В., Крицкая Т.Б. Разработка топологии охранных колец мощных кремниевых диодов с блокирующим напряжением до 6,7 кВ. Т. 23, № 3, с. 260–267.

Супонников Д.А., Путилин А.Н., Татарина Е.А., Жгунев З.Г., Дабагов А.Р. Разработка фоточувствительной ячейки матричного фотосенсора для детектора рентгеновского изображения. Т. 23, № 6, с. 573–585.

Тимошенков В.П., Фатеев И.А. Топологический подход к увеличению устойчивости DICE-триггеров к воздействию тяжелых заряженных частиц. Т. 23, № 3, с. 252–259.

Егоркин В.И., Земляков В.Е., Неженцев А.В., Гармаш В.И. Исследование методов вжигания омических контактов к n -слоям гетеробиполярных наногетероструктур. Т. 23, № 1, с. 15–22.

Егоркин В.И., Земляков В.Е., Неженцев А.В., Гудков В. А., Гармаш В.И. Влияние состава металлизации и параметров процесса вжигания на сопротивление омических контактов к $6H-SiC$ n -типа. Т. 23, № 6, с. 557–564.

Петренко Н.Ю., Пучнина С.В., Гаврилов С.А. Математическая модель процесса испарения компонентов амальгамы в разрядных источниках излучения. Т. 23, № 2, с. 124–132.

Поголов А.И., Блинов Г.А., Чугунов Е.Ю. Моделирование клеевых соединений для обеспечения надежности трехмерных микроэлектронных модулей. Т. 23, № 1, с. 23–31.

Рехвиашвили С.Ш., Мамчурев М.О., Нарожнов В.В., Ойхунов М.М., Тлибеков А.Х. Исследование влияния плотности монтажа компонентов на колебательные характеристики многослойных печатных плат. Т. 23, № 2, с. 141–148.

Федотов С.Д., Соколов Е.М., Стаценко В.Н., Ромашкин А.В., Тимошенков С.П. Исследование технологических режимов газофазного формирования начального слоя кремния на сапфире. Т. 23, № 5, с. 454–467.

Ханг Тхи Нгуен, Якубов А.О., Лазаренко П.И., Волкова А.В., Шерченков А.А., Козюхин С.А. Особенности характеристик аморфных полупроводниковых пленок As_2S_3 , полученных методом центрифугирования раствора. Т. 23, № 2, с. 149–160.

Элементы интегральной электроники

Булатов З.В., Путилин А.Н., Супонников Д.А., Кочетов А.В., Татарина Е.А., Дабагов А.Р. Анализ схем построения стеков преобразования рентгеновского излучения и моделирование процессов формирования сигнала рентгеновского изображения в фотоприемнике. Т. 23, № 2, с. 173–185.

Елизаров Г.С., Корнеев В.В., Тарасов И.Е., Советов П.Н. Основные тенденции развития архитектур специализированных многоядерных процессоров. ОБЗОР. Т. 23, № 2, с. 161–172.

Жаднов В.В. Модель отказов электронных компонентов для расчета надежности. Т. 23, № 4, с. 353–361.

Королёв М.А., Ключников А.С., Ефимова Д.И. Беспереходной МОП-транзистор с низким подпороговым током. Т. 23, № 2, с. 186–193.

Королев М.А., Ключников А.С., Ефимова Д.И. Влияние расположения контактов стокистоковых областей на параметры беспереходного КНИ МОП-транзистора. Т. 23, № 4, с. 345–352.

Рыбаков А.А., Резниченко Н.Е. Измерение нелинейности АЦП при входном сигнале неполной шкалы. Т. 23, № 1, с. 32–39.

Сопова О.В., Крицкая Т.Б. Разработка топологии охранных колец мощных кремниевых диодов с блокирующим напряжением до 6,7 кВ. Т. 23, № 3, с. 260–267.

Супонников Д.А., Путилин А.Н., Татарина Е.А., Жгунов З.Г., Дабагов А.Р. Разработка фоточувствительной ячейки матричного фотосенсора для детектора рентгеновского изображения. Т. 23, № 6, с. 573–585.

Тимошенков В.П., Фатеев И.А. Топологический подход к увеличению устойчивости DICE-триггеров к воздействию тяжелых заряженных частиц. Т. 23, № 3, с. 252–259.

Схемотехника и проектирование

Дембицкий Н.Л., Петраков А.М., Шевцов В.А. Автоматизация управления процессом создания сложных радиотехнических систем. Т. 23, № 6, с. 586–594.

Иванова Г.А., Рыжова Д.И. Методы повышения точности моделирования задержек и пиковых токов комбинационных КМОП-схем на логическом уровне проектирования. Т. 23, № 1, с. 40–51.

Микро- и наносистемная техника

Амеличев В.В., Григорьев Д.М., Резнев А.А. Конечно-элементное моделирование мембранного модуля. Т. 23, № 3, с. 277–284.

Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П. Исследование балочных резонаторов для частотных акселерометров с учетом термоупругого демпфирования и остаточного напряжения. Т. 23, № 1, с. 52–61.

Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П., Шилов В.Ф., Чжо Мьё Аунг. Исследование влияния температуры на работу резонатора частотного микромеханического акселерометра. Т. 23, № 3, с. 268–276.

Панов А.П., Серов А.Н. Измерение скорости воздушного потока с использованием ультразвуковых преобразователей. Т. 23, № 5, с. 486–494.

Рябов В.Т., Дюжнев Н.А., Новиков Д.В. Автоматизация процесса измерения параметров чувствительных элементов датчиков расхода газа. Т. 23, № 1, с. 62–71.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Баранов А.А., Сергеев В.А. Радиоволновой способ контроля неоднородности электрофизических параметров диэлектриков с использованием сканирующей микрополосковой линии. Т. 23, № 5, с. 468–476.

Ефимов А.Г., Купцов Е.О., Мартынова В.П., Спиридонов А.Б., Сурин Ю.В. Прецизионный аналого-цифровой фазовращатель с изменением фазы 0–360° L -диапазона. Т. 23, № 3, с. 285–292.

Зосимов В.В., Сизов В.И., Переверзев А.Л., Савченко Ю.В. Особенности сбора и обработки информации для исследования радиолокационных отражений от растительности. Т. 23, № 4, с. 362–370.

Лялин К.С., Орешкин В.И., Хасанов М.С., Мелёшин Ю.М., Довгаль Т.А. Метод улучшения разрешающей способности в радиолокаторах с фазокодовой манипуляцией. Т. 23, № 4, с. 371–378.

Садков В.Д., Фомина К.С., Пилькевич А.В. Поглощающие элементы на основе однородной резистивной пленки для реализации широкого диапазона ослаблений мощности радиосигналов. Т. 23, № 5, с. 477–485.

Якунин А.Н., Аунг Мьё Сан. Сравнительный анализ характеристик двоичных многоурядных параллельных сумматоров. Т. 23, № 3, с. 293–303.

Биомедицинская электроника

Пономарев О.П., Пономарев В.О. Моделирование локальных электромагнитных полей в нанобиокомплексах на основе квантовых точек InP/ZnS. Т. 23, № 1, с. 72–83.

Информационно-коммуникационные технологии

- Бархоткин В.А., Кочетков М.П.** Многогипотезное распознавание трехмерных объектов на зашумленных изображениях. Т. 23, № 4, с. 379–388.
- Волков А.С., Бахтин А.А., Миронов А.В., Муратчаев С.С., Заболотный А.С.** Моделирование процедуры восстановления маршрута в беспроводных сетях MANET. Т. 23, № 1, с. 84–92.
- Гаврилов Д.А., Павлов А.В.** Поточная аппаратная реализация алгоритма SURF. Т. 23, № 5, с. 502–511.
- Галкин В.А.** Непараметрическое обнаружение сигналов детектором средней энергии. Т. 23, № 6, с. 595–604.
- Колдаев В.Д., Наинг Линн Аунг.** Метод сшивания кадров аэрофотоснимков в системах видеонаблюдения Т. 23, № 2, с. 194–202.
- Макаров Д.В., Чобану М.К.** Сжатие трехмерных табулированных таблиц с помощью тензорной декомпозиции. Т. 23, № 6, с. 605–614.
- Пастухов А.А., Прокофьев А.А.** Алгоритм формирования обучающего множества и уточнения характеристики нейрона сети типа многослойный персептрон. Т. 23, № 5, с. 512–520.
- Петров В.Ф., Симонов С.Б., Терентьев А.И., Петров О.В., Корольков Д.Н.** Сетевая структура обработки информации в распределенных системах управления наземными робототехническими комплексами. Т. 23, № 4, с. 389–398.
- Тикменов В.Н., Ухандеев В.И., Собченко М.И., Денискин М.Ю.** Система помехоустойчивого кодирования на основе квазициклических кодов с низкой плотностью проверок на четность. Т. 23, № 4, с. 399–409.
- Шарилов А.И., Шарикова Е.М.** ПЛИС-система выделения ключевых точек при обработке изображений. Т. 23, № 5, с. 495–501.

Проблемы высшего образования

- Балабанов А.А., Переверзев А.Л., Стрекопытов Д.В.** Систематизация подходов к анализу и разработке аналоговых электронных схем. Т. 23, № 4, с. 410–419.
- Коробова Н.Е., Косолапова Г.В.** Использование электронного компонента в самостоятельной работе студентов дисциплины «Materials for electronics» для формирования исследовательских навыков. Т. 23, № 2, с. 203–208.
- Прокофьева В.К., Трояновский В.М., Чжо Наинг Сог.** Виртуальная учебная лаборатория «Выращивание монокристаллов». Т. 23, № 4, с. 420–428.

Краткие сообщения

- Акинишин Н.С., Хомяков Д.А., Меньшиков В.Л.** Многофункциональная сейсмоакустическая информационно-измерительная система для обнаружения движущихся наземных объектов. Т. 23, № 1, с. 98–102.
- Алексахин А.В., Гулидов Д.Н.** Автоматизированная система выбора оптимального технологического процесса резки слитков полупроводниковых и диэлектрических материалов на пластины Т. 23, № 1, с. 103–106.
- Аишотов О.Г., Хубежов С.А., Аишотова И.Б.** Состояние поверхности поликристаллического серебра после воздействия активированным кислородом. Т. 23, № 6, с. 620–624.

- Белогорохов И.А., Белогорохова Л.И.** Оптические свойства композиционных материалов на основе поли[2-метокси-5-(2-этилгексилокси)-1,4-фениленвинилена] и диоксида титана в средней ИК- области. Т. 23, № 6, с. 615–619.
- Кузьминов И.В., Новожилов И.С., Лосев В.В.** Алгоритм построения и оценки структуры коммутационных блоков ИПИС с заданным количеством связей. Т. 23, № 5, с. 526–530.
- Петросянец К.О., Попов Д.А.** Моделирование эффекта саморазогрева КНИ МОП-транзистора с различной конфигурацией скрытого оксида. Т. 23, № 5, с. 521–525.
- Сергеев В.А., Резчиков С.Е.** Аналоговый генератор низкочастотного шума с регулируемым показателем формы спектра. Т. 23, № 6, с. 635–639.
- Сергеев В.А., Тарасов Р.Г., Куликов А.А.** Выборочные распределения субмодулей выходных усилителей мощности АФАР X-диапазона по энергетическим параметрам. Т. 23, № 1, с. 93–97.
- Симонов Б.М., Горошко В.Н., Тимошенко А.С.** Расчет коэффициентов жесткости и момента упругости чувствительного элемента микромеханического акселерометра. Т. 23, № 6, с. 625–629.
- Слюсарь В.В.** Модель оценки эффективности информационного поиска в рамках концепции Семантического Web. Т. 23, № 3, с. 308–313.
- Тарасенко А.М.** Выбор вида излучаемых сигналов радиотехнических средств на основании анализа корреляционных свойств модулирующих функций. Т. 23, № 5, с. 531–534.
- Хамдохов З.М., Маргушев З.Ч., Хамдохов Э.З., Тешев Р.Ш., Бавижев М.Д.** Автоэмиссионные катоды на основе микроканальных пластин. Т. 23, № 6, с. 630–634.
- Щагин А.В., Йе Наунг, Зо Мин Кхаинг.** Режимы управления двигателем постоянного тока с замкнутым контуром в высокоточных системах позиционирования. Т. 23, № 3, с. 304–307.

Юбилей

- Бархоткину Вячеславу Александровичу – 80 лет. Т. 23, № 1, с. 107.
- Королёву Михаилу Александровичу – 85 лет. Т. 23, № 2, с. 209–210.
- Красникову Геннадию Яковлевичу – 60 лет. Т. 23, № 3, с. 313–314.
- Соколову Евгению Борисовичу – 85 лет. Т. 23, № 3, с. 315–316.
- Усанову Дмитрию Александровичу – 75 лет. Т. 23, № 4, с. 429–430.

Конференции

- 8 февраля – День российской науки. Т. 23, № 2, 2-я стр. обложки.
- VIII Всероссийская конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем». Т. 23, № 4, 3 стр. обложки.
- 6-я Международная научно-техническая конференция «Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике» (20–22 февраля 2019 г., ИНМЭ РАН, г. Москва, Россия). Т. 23, № 5, 2 стр. обложки. Т. 23, № 6, 3 стр. обложки.
- Иванников А.Д., Петросянец К.О.** Об итогах VIII Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем - 2018» (МЭС-2018) (1–5 октября 2018 г., г. Москва, г. Зеленоград, Россия). Т. 23, № 6, с. 640–642.
- Ичкитидзе Л.П.** О новой разработке ученых Института биомедицинских систем МИЭТ. XLV. Congress of the European Society for Artificial Organs (ESAO) (Madrid, Spain, September, 12–15, 2018). Т. 23, № 6, с. 643.
- К 100-летию со дня рождения Преснухина Леонида Николаевича. Т. 23, № 4, с. 324–326.